

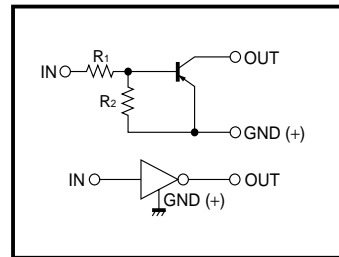
# デジタルトランジスタ (抵抗内蔵トランジスタ)

## DTA115EM / DTA115EE / DTA115EUA / DTA115EKA / DTA115ESA

### ●特長

- 1) バイアス用の抵抗を内蔵しているため、入力側の外付け抵抗なしでインバータ回路が構成できる。(等価回路図参照)
- 2) バイアス用の抵抗は薄膜により構成し完全にアイソレートしているため、入力を正にバイアスでき、寄生効果もほとんど生じない。
- 3) ON/OFF 条件の設定だけで動作するため、機器の設計が容易に行える。
- 4) 実装密度の向上を図ることができる。

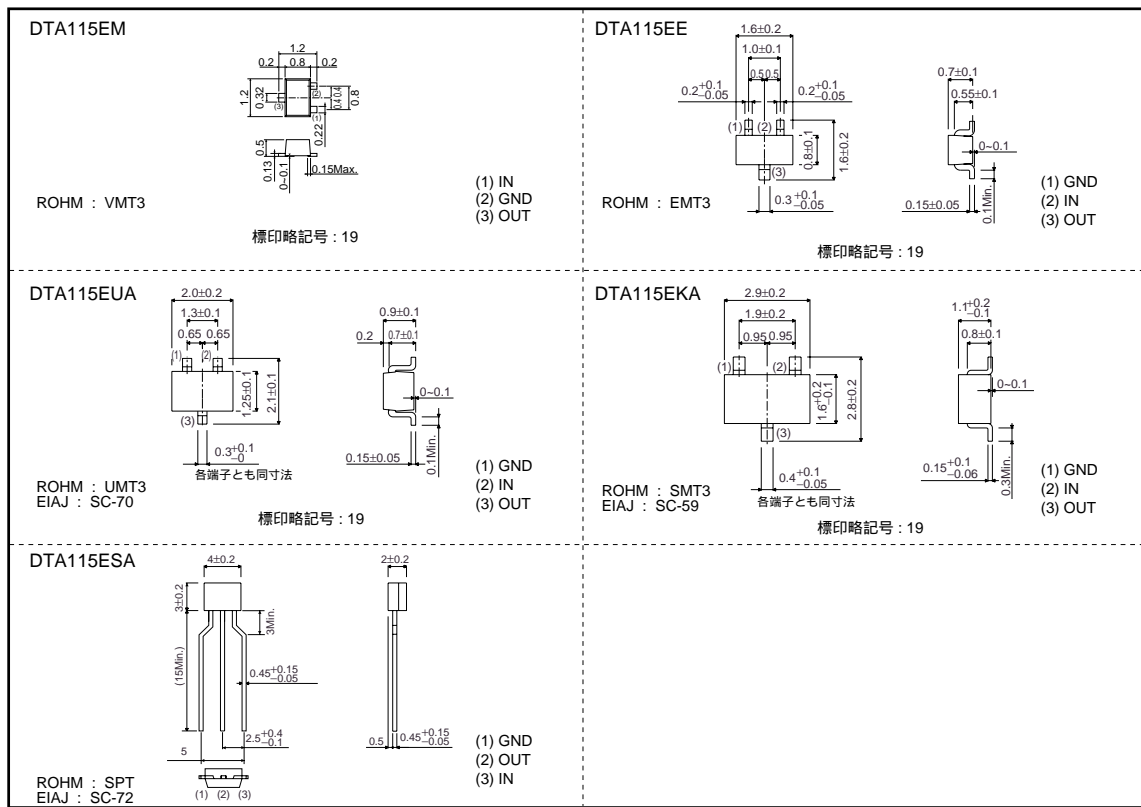
### ●内部等価回路図



### ●構造

PNP デジタルトランジスタ (抵抗内蔵トランジスタ)

### ●外形寸法図 (Units : mm)



# DTA115EM / DTA115EE / DTA115EUA / トランジスタ DTA115EKA / DTA115ESA

## ●絶対最大定格 (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
電源電圧	V <sub>cc</sub>	-50	V
入力電圧	V <sub>i</sub>	-40~+10	V
出力電流	I <sub>o</sub>	-20	mA
	I <sub>c(Max.)</sub>	-100	
許容損失	P <sub>d</sub>	DTA115EM / DTA115EE	150
		DTA115EUA / DTA115EKA	200
		DTA115ESA	300
接合部温度	T <sub>J</sub>	150	°C
保存温度範囲	T <sub>stg</sub>	-55~+150	°C

## ●電気的特性 (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
入力電圧	V <sub>i(off)</sub>	-	-	-0.5	V	V <sub>cc</sub> =-5V, I <sub>o</sub> =-100μA
	V <sub>i(on)</sub>	-3	-	-		V <sub>o</sub> =-0.3V, I <sub>o</sub> =-1mA
出力電圧	V <sub>o(on)</sub>	-	-0.1	-0.3	V	I <sub>o</sub> =-5mA, I <sub>i</sub> =-0.25mA
入力電流	I <sub>i</sub>	-	-	-0.15	mA	V <sub>i</sub> =-5V
出力電流	I <sub>o(off)</sub>	-	-	-0.5	μA	V <sub>cc</sub> =-50V, V <sub>i</sub> =0V
直流電流増幅率	G <sub>i</sub>	82	-	-	-	I <sub>o</sub> =-5mA, V <sub>o</sub> =-5V
入力抵抗	R <sub>1</sub>	70	100	130	kΩ	-
抵抗比率	R <sub>2</sub> /R <sub>1</sub>	0.8	1	1.2	-	-
利得帯域幅積	f <sub>r</sub>	-	250	-	MHz	V <sub>ce</sub> =10V, I <sub>e</sub> =-5mA, f=100MHz *

\*構成トランジスタの特性です。

## ●パッケージ、標印及び包装仕様

Type	DTA115EM	DTA115EE	DTA115EUA	DTA115EKA	DTA115ESA
パッケージ名	VMT3	EMT3	UMT3	SMT3	SPT
標印	19	19	19	19	-
包装記号	T2L	TL	T106	T146	TP
基本発注単位 (個)	8000	3000	3000	3000	5000